

# 日程表 (分科別 I)

大分類分科名	2018年3月17日(土)		2018年3月18日(日)		2018年3月19日(月)		2018年3月20日(火)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
SP 特別シンポジウム								
SP1 クラウドとIoTエッジの相乗作用によるスマート社会へのロードマップ ～コンピュータサイエンスと半導体物理の複眼視点からの未来予測～		G201 12:58 ~ 17:46						
SP2 物質と宇宙の基礎研究とそれがもたらす最先端産業技術		G203 13:15 ~ 18:00						
SP3 幸運の前髪を掴む～女神には前髪しかない～		C304 13:30 ~ 17:25						
SP4 「科学技術立国日本」の凋落危機を救う若手研究者の活躍推進		A204 13:00 ~ 18:00						
SP5 JSAP-SPIE Joint Symposium		C104 13:45 ~ 18:00						
SP6 集積化MEMSの発展と展望 (集積化MEMS技術研究会発足 10周年記念シンポジウム)			G201 13:00 ~ 18:30					
SP7 快適な未来社会を拓く ～高分子科学と応用物理学の協奏～					E201 13:00 ~ 17:30			
SP8 AI・IoT・ビッグデータで爆発的に拡大する半導体産業を支える日本の技術 ～若手社員の現場の声とともに～					G201 10:00 ~ 12:00			
S シンポジウム								
S1 熱音響				F102 13:45 ~ 18:05				
S2 再生可能エネルギーの高度利用に向けた材料・デバイス技術の進展					F102 10:15 ~ 12:15	F102 13:45 ~ 17:15		
S3 真の放射線生体影響解明に向けて進む放射光マイクロビーム評価技術				A304 13:15 ~ 16:30				
S4 光波センシングにおける偏光イメージング技術				C303 13:45 ~ 17:30				
S5 高強度レーザーによる物質変換～材料プロセスの展開				A404 13:15 ~ 18:00				
S6 量子コンピュータと量子シミュレーションの現状と展望				A302 13:30 ~ 16:45				
S7 フレキシブルセラミックスコーティング技術と有機・無機ハイブリッドフレキシブルデバイスの新展開			C103 09:15 ~ 11:45	C103 13:30 ~ 18:00				
S8 チップ増強ラマン散乱 (TERS) の最前線				F210 13:45 ~ 17:45				
S9 圧電薄膜の基礎技術と応用デバイス				C104 13:00 ~ 17:00				
S10 イオンビームと表面分析：二次イオン質量分析法 (SIMS) の最近の進歩と有機分析への応用				C201 13:45 ~ 17:30				
S11 先端3D原子イメージングが拓く新しい材料・デバイス技術						C103 13:45 ~ 17:45		
S12 進展めざましい電子源と最近の新たなアプリケーション						C102 13:45 ~ 17:45		
S13 二次元シート合成とプラズマプロセス～超薄膜から原子層まで～				C204 13:45 ~ 18:00				
S14 IoT時代に向けたナノワイヤデバイス展開とその物理				F104 13:30 ~ 17:45				
S15 ニューロモルフックハードウェアとはどんなものだろうか？				D104 13:15 ~ 17:00				
S16 磁気科学研究の今と未来						A202 13:15 ~ 17:30		
S17 超伝導材料を舞台に活躍する数値シミュレーション技術 ～物理現象、結晶成長、そしてアプリケーション設計まで～	B401 13:00 ~ 17:00							
S18 pMAIRS法：非平滑・非晶質薄膜の分子配向を明らかにできる新手法	B201 13:15 ~ 17:00							
S19 先端計測と機械学習の融合						D102 13:15 ~ 16:45		
S20 化合物電子デバイス・プロセス技術の進展 ～GaAsの繁栄から学ぶ・温故知新～	E201 13:15 ~ 16:20							
S21 多元化合物の新規な物性と応用	C102 13:45 ~ 18:30							
S22 デバイスシミュレーション技術の活用と将来展望				A202 13:15 ~ 18:40				
S23 ゲルマニウムはシリコンを代替するのか？						G203 13:30 ~ 17:10		
S24 集積化センサシステムによるコピキタス健康管理を目指して						C101 13:45 ~ 19:05		
S25 日本の半導体産業・研究の明るい未来を描く						G201 13:15 ~ 17:35		
S26 分野融合で始まる欠陥研究の新時代 ～学会を越えた視点から見えてくるもの～	C302 13:45 ~ 17:30							
S27 ゲルマニウムの工学 – 電子・光・熱・スピン IV族半導体の新展開 –				C304 13:00 ~ 17:25				
S28 複合アニオン化合物による革新的新機能材料の創製				A402 13:15 ~ 16:25				
S29 窒化物半導体特異構造の科学 ～格子欠陥はどこまで制御できるのか：先端評価と機能探索～						E202 13:30 ~ 17:30		
S30 テラワット発電に向けて：結晶シリコン太陽電池技術の新たな展開	D101 13:00 ~ 18:30							
S31 太陽電池分野で活躍する女性達						D101 13:15 ~ 18:00		
S32 無機・有機複合材料で放熱問題に挑む ～物理と応用の最前線～						C304 13:15 ~ 18:50		
T チュートリアル								
T1 硬質材料表面のナノ機械特性評価技術/ソフトマテリアルのナノ科学物性評価技術	C103 9:00 ~ 11:30							
T2 プラズマ微細加工技術の基礎と応用?エッチング基礎から原子層エッチングまで	C104 9:00 ~ 11:30							
T3 スピントロニクス入門	C102 9:00 ~ 11:30							
T4 フレキシブルエナジーハーベスターのための有機系熱電材料入門	A204 9:00 ~ 11:30							

# 日程表 (分科別Ⅱ)

大分類分科名 中分類分科名	2018年3月17日(土)		2018年3月18日(日)		2018年3月19日(月)		2018年3月20日(火)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
CS コードシェアセッション								
CS.1 3.5 レーザー装置・材料,3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション			B303 09:00 ~ 10:15					
CS.2 3.11 フォトニック構造・現象,3.12 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション					C301 09:00 ~ 11:45			
CS.3 3.11 フォトニック構造・現象,13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードシェアセッション				C301 13:45 ~ 18:15				
CS.4 6.5 表面物理・真空,7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション						F214 13:45 ~ 17:00		
CS.5 6.6 プロブ顕微鏡,12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション					F210 09:45 ~ 12:00			
CS.6 10.1 新物質・新機能創成(作製・評価技術),10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術,10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術のコードシェアセッション					D104 09:00 ~ 12:00	D104 13:00 ~ 14:30		
1 応用物理学一般								
1.1 応用物理一般・学際領域		P1 13:30 ~ 15:30		F202 13:15 ~ 18:30				
1.2 教育			P1 09:30 ~ 11:30					
1.3 新技術・複合新領域		P2 13:30 ~ 15:30	F202 09:00 ~ 11:45					
1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境					P1 09:30 ~ 11:30		F102 09:00 ~ 12:15	
1.5 計測技術・計測標準						P1 13:30 ~ 15:30	F202 09:15 ~ 12:00	F202 13:45 ~ 16:00
1.6 超音波			F102 10:00 ~ 11:45		B303 09:00 ~ 11:45	P2 13:30 ~ 15:30		
2 放射線								
2.1 放射線物理一般・検出器基礎		A304 14:00 ~ 18:30				P7 16:00 ~ 18:00		
2.2 検出器開発							A304 09:00 ~ 12:00	A304 13:15 ~ 16:30
2.3 放射線応用・発生装置・新技術			A304 10:00 ~ 11:45		A304 09:00 ~ 11:45	A304 13:15 ~ 15:30		
						P7 16:00 ~ 18:00		
3 光・フォトニクス								
3.1 光学基礎・光学新領域						B203 13:15 ~ 18:30	B203 09:30 ~ 11:30	P1 13:30 ~ 15:30
3.2 材料・機器光学		B203 13:15 ~ 16:45	P2 09:30 ~ 11:30					
3.3 情報フォトニクス・画像工学					P2 09:30 ~ 11:30	B201 13:15 ~ 19:00		
3.4 生体・医用光学						A302 13:15 ~ 19:30		P2 13:30 ~ 15:30
3.5 レーザー装置・材料	B403 09:00 ~ 11:15	B403 13:15 ~ 18:00		P1 13:30 ~ 15:30				
CS.1 3.5 レーザー装置・材料,3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション			B303 09:00 ~ 10:15					
3.6 超高速・高強度レーザー					B301 09:00 ~ 12:00	B301 13:15 ~ 19:30	B301 09:00 ~ 12:00	P3 13:30 ~ 15:30
3.7 レーザープロセス					A404 09:00 ~ 11:45	A404 13:15 ~ 18:45	P1 09:30 ~ 11:30	
3.8 光計測技術・機器					C303 09:00 ~ 12:15	C303 13:45 ~ 19:00	P2 09:30 ~ 11:30	C303 13:45 ~ 16:45
3.9 テラヘルツ全般					P3 09:30 ~ 11:30	A402 13:30 ~ 17:15	A402 09:00 ~ 12:00	A402 13:15 ~ 17:00
3.10 光量子物理・技術			A302 09:30 ~ 11:45		A302 09:00 ~ 11:45	P3 13:30 ~ 15:30	A302 09:00 ~ 11:30	
3.11 フォトニック構造・現象						C301 13:45 ~ 18:30	P3 09:30 ~ 11:30	C301 13:00 ~ 16:30
CS.2 3.11 フォトニック構造・現象,3.12 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション					C301 09:00 ~ 11:45			
CS.3 3.11 フォトニック構造・現象,13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードシェアセッション				C301 13:45 ~ 18:15				
3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	A402 09:00 ~ 12:00	A402 13:30 ~ 18:30	A402 09:00 ~ 12:00	P9 16:00 ~ 18:00		F310 13:30 ~ 17:30		
CS.2 3.11 フォトニック構造・現象,3.12 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション					C301 09:00 ~ 11:45			
3.13 半導体光デバイス	B203 09:30 ~ 12:15	P3 13:30 ~ 15:30	B203 09:00 ~ 12:00	B203 13:15 ~ 18:00	B203 09:00 ~ 11:45			
3.14 光制御デバイス・光ファイバー		P4 13:30 ~ 15:30	B303 10:30 ~ 11:30					
		B303 16:00 ~ 19:15						
CS.1 3.5 レーザー装置・材料,3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション			B303 09:00 ~ 10:15					
3.15 シリコンフォトニクス			B201 09:30 ~ 11:45	B201 13:15 ~ 17:30	B201 09:30 ~ 11:45		P4 09:30 ~ 11:30	
3.16 Optics and Photonics English Session		A404 13:15 ~ 17:00		P10 16:00 ~ 18:00				



さらに細かい日程表は、アプリやwebプログラムのタイムテーブルをご覧ください

# 日程表（分科別Ⅲ）

大分類分科名 中分類分科名	2018年3月17日(土)		2018年3月18日(日)		2018年3月19日(月)		2018年3月20日(火)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
6 薄膜・表面								
6.1 強誘電体薄膜					C104 09:00 ~ 12:15	C104 13:15 ~ 18:30	P5 09:30 ~ 11:30	
6.2 カーボン系薄膜			F206 09:00 ~ 11:30	F206 13:45 ~ 18:00	F206 09:00 ~ 12:15	P4 13:30 ~ 15:30		
						F206 16:15 ~ 19:00		
6.3 酸化物エレクトロニクス			C102 09:00 ~ 12:00	C102 13:45 ~ 18:00	C102 09:00 ~ 12:00	P5 13:30 ~ 15:30	C102 09:00 ~ 12:15	C102 13:45 ~ 16:30
6.4 薄膜新材料		C103 13:45 ~ 18:00			C103 09:00 ~ 12:15	P6 13:30 ~ 15:30	C103 09:00 ~ 12:00	
6.5 表面物理・真空				P2 13:30 ~ 15:30	F214 09:15 ~ 12:15			
CS.4 6.5 表面物理・真空,7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション						F214 13:45 ~ 17:00		
6.6 プローブ顕微鏡		P5 13:30 ~ 15:30	F210 09:00 ~ 12:30			F210 13:15 ~ 17:30		
CS.5 6.6 プローブ顕微鏡,12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション					F210 09:45 ~ 12:00			
7 ビーム応用								
7.1 X線技術			P3 09:30 ~ 11:30					B301 13:15 ~ 16:45
7.2 電子ビーム応用							B303 09:45 ~ 12:45	B303 14:00 ~ 16:15
7.3 微細パターン・微細構造形成技術			P4 09:30 ~ 11:30				B401 10:30 ~ 12:00	B401 13:00 ~ 16:15
7.4 量子ビーム界面構造計測	F202 09:00 ~ 12:15							
7.5 イオンビーム一般			P3 09:30 ~ 11:30				B403 09:00 ~ 11:45	
7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術								
CS.4 6.5 表面物理・真空,7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション						F214 13:45 ~ 17:00		
8 プラズマエレクトロニクス								
8.1 プラズマ生成・診断		C204 13:15 ~ 18:30						
8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理						C204 13:45 ~ 18:15	C204 09:00 ~ 12:15	
8.3 プラズマナノテクノロジー					C201 09:00 ~ 12:00			
8.4 プラズマライフサイエンス						C201 13:45 ~ 19:00		P4 13:30 ~ 15:30
8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野		C201 13:15 ~ 18:15	C204 10:15 ~ 10:45					
8.6 Plasma Electronics English Session			C204 09:00 ~ 10:15					
8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演			C204 11:00 ~ 11:30					
8.8 プラズマエレクトロニクス賞授賞式			C204 11:30 ~ 11:45					
9 応用物性								
9.1 誘電材料・誘電体							P6 09:30 ~ 11:30	F104 13:45 ~ 16:45
9.2 ナノワイヤ・ナノ粒子					F104 09:15 ~ 12:00	F104 13:30 ~ 15:30	F104 09:30 ~ 11:30	
						P8 16:00 ~ 18:00		
9.3 ナノエレクトロニクス		F210 13:30 ~ 17:15	P5 09:30 ~ 11:30					
9.4 熱電変換	F102 09:00 ~ 12:15	F102 13:45 ~ 18:30		P3 13:30 ~ 15:30				
9.5 新機能材料・新物性		F202 13:45 ~ 17:15	P6 09:30 ~ 11:30					
10 スピントロニクス・マグネティクス								
CS.6 10.1 新物質・新機能創成（作製・評価技術）,10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術,10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術のコードシェアセッション					D104 09:00 ~ 12:00	D104 13:00 ~ 14:30		
10.1 新物質・新機能創成（作製・評価技術）		P10 16:00 ~ 18:00				D104 14:45 ~ 19:00		
10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術		D104 13:00 ~ 15:30	D104 09:00 ~ 09:45					
10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術								
10.4 半導体スピントロニクス・超伝導・強相関		P10 16:00 ~ 18:00	D104 10:00 ~ 12:00				D104 09:00 ~ 12:00	D104 13:00 ~ 16:00
10.5 磁場応用					A202 09:00 ~ 12:15			
11 超伝導								
11.1 基礎物性					B401 09:00 ~ 12:00	B401 13:15 ~ 16:00		
11.2 薄膜，厚膜，テープ作製プロセスおよび結晶成長					B403 13:15 ~ 18:30			
11.3 臨界電流，超伝導パワー応用			P7 09:30 ~ 11:30			B403 13:15 ~ 16:30		
11.4 アナログ応用および関連技術						B303 13:15 ~ 18:15		
11.5 接合，回路作製プロセスおよびデジタル応用					B303 13:15 ~ 16:30			

# 日程表 (分科別Ⅳ)

大分類分科名 中分類分科名	2018年3月17日(土)		2018年3月18日(日)		2018年3月19日(月)		2018年3月20日(火)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
12 有機分子・バイオエレクトロニクス								
12.1 作製・構造制御			G205 09:00 ~ 11:30	G205 13:15 ~ 18:00	G205 09:00 ~ 11:30		P7 09:30 ~ 11:30	
12.2 評価・基礎物性		F104 13:45 ~ 18:15	F104 09:00 ~ 12:15	P11 16:00 ~ 18:00		G202 13:15 ~ 16:30		
CS.5 6.6 フロー顕微鏡, 12.2 評価・基礎物性のコードシェアセッション								
12.3 機能材料・萌芽的デバイス		P6 13:30 ~ 15:30	A204 09:00 ~ 11:45	A204 13:15 ~ 18:15	A204 09:00 ~ 11:45		A204 09:00 ~ 11:45	A204 13:15 ~ 15:15
12.4 有機EL・トランジスタ	D102 09:00 ~ 11:45	D102 13:15 ~ 18:30	P8 09:30 ~ 11:30	D102 13:15 ~ 19:30	D102 09:00 ~ 11:45		D102 09:00 ~ 12:00	
12.5 有機太陽電池	G202 09:00 ~ 11:15	G202 12:45 ~ 18:45	G202 09:00 ~ 12:15	P4 13:30 ~ 15:30	G202 09:00 ~ 11:15		G202 09:00 ~ 11:45	
				G202 16:00 ~ 18:30				
12.6 ナノバイオテクノロジー	A202 09:00 ~ 11:15	A202 13:00 ~ 18:30	A202 09:00 ~ 11:45	P5 13:30 ~ 15:30				
12.7 医用工学・バイオチップ	F306 09:00 ~ 12:15	F306 13:45 ~ 15:30	F306 09:00 ~ 12:15	F306 13:45 ~ 18:30	F306 09:00 ~ 12:15			
		P11 16:00 ~ 18:00						
13 半導体								
13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション			B301 09:00 ~ 12:00	B301 13:00 ~ 15:45				
				P12 16:00 ~ 18:00				
13.2 探索的材料物性・基礎物性				P6 13:30 ~ 15:30	F202 09:30 ~ 12:15	F202 13:45 ~ 18:15		
13.3 絶縁膜技術	F206 09:00 ~ 12:30	F206 13:45 ~ 18:15		P7 13:30 ~ 15:30				
13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・配線・MEMS・集積化技術	C101 09:30 ~ 12:30	P7 13:30 ~ 15:30					C101 09:15 ~ 11:45	C101 13:45 ~ 16:45
		C101 16:00 ~ 17:30						
13.5 デバイス/集積化技術		P8 13:30 ~ 15:30	G203 09:00 ~ 12:15	G203 13:15 ~ 18:00	G203 09:00 ~ 12:00			
13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス		F314 14:00 ~ 17:30	P9 09:30 ~ 11:30					
CS.3 3.11 フォトリソグラフィ・現象, 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイスのコードシェアセッション								
13.7 化合物及びパワー電子デバイス・プロセス技術		P12 16:00 ~ 18:00	C302 09:00 ~ 12:15	C302 13:45 ~ 19:00	C302 09:00 ~ 12:15	C302 13:45 ~ 18:30		
13.8 光物性・発光デバイス			G204 09:30 ~ 11:30	G204 13:15 ~ 17:30	G204 09:00 ~ 11:45	G204 13:15 ~ 15:15	G204 09:45 ~ 11:45	
						P9 16:00 ~ 18:00		
13.9 化合物太陽電池	F310 09:00 ~ 12:00		F310 09:45 ~ 11:45	F310 13:45 ~ 15:30	F310 09:45 ~ 11:45			
				P13 16:00 ~ 18:00				
15 結晶工学								
15.1 バルク結晶成長	B301 09:00 ~ 12:15	P9 13:30 ~ 15:30						
		B301 16:00 ~ 18:30						
15.2 II-VI族結晶および多元系結晶							F210 09:00 ~ 10:30	P5 13:30 ~ 15:30
15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎		F214 13:45 ~ 17:30		P8 13:30 ~ 15:30				
15.4 III-V族窒化物結晶	E202 09:00 ~ 11:45	E202 13:15 ~ 18:30	E202 09:00 ~ 11:45	E202 13:15 ~ 19:30	E202 09:00 ~ 11:45		E202 09:00 ~ 11:45	P6 13:30 ~ 15:30
15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶						P10 16:00 ~ 18:00	F214 09:45 ~ 12:00	F214 13:30 ~ 15:45
15.6 IV族系化合物 (SiC)				P14 16:00 ~ 18:00	D103 09:00 ~ 12:15	D103 13:30 ~ 18:00	D103 09:00 ~ 12:00	D103 13:15 ~ 17:00
15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥			D103 09:00 ~ 11:45	D103 13:15 ~ 19:30	P4 09:30 ~ 11:30			
16 非晶質・微結晶								
16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス					P5 09:30 ~ 11:30		G203 09:00 ~ 11:45	G203 13:15 ~ 15:30
16.2 エナジーハーベスティング							P8 09:30 ~ 11:30	G204 13:45 ~ 15:00
16.3 シリコン系太陽電池	D101 09:45 ~ 11:45		D101 09:00 ~ 11:45	D101 13:15 ~ 18:00	D101 09:15 ~ 11:45		P9 09:30 ~ 11:30	
17 ナノカーボン								
17.1 カーボンナチューブ, 他のナノカーボン材料	C303 10:00 ~ 12:00	C303 13:45 ~ 18:00	C303 10:00 ~ 12:00					
17.2 グラフェン	C202 10:00 ~ 12:00	C202 13:45 ~ 17:45	C202 09:00 ~ 12:15	C202 13:45 ~ 16:00	P6 09:30 ~ 11:30			
17.3 層状物質						C202 13:45 ~ 18:30	C202 10:00 ~ 12:15	C202 13:45 ~ 15:30
21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」								
21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」			E201 09:00 ~ 12:15	E201 13:45 ~ 17:15	E201 10:00 ~ 11:45	P11 16:00 ~ 18:00	E201 09:00 ~ 11:30	E201 13:00 ~ 16:00
22 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」								
22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」				P15 16:00 ~ 18:00	C304 09:30 ~ 11:45		C304 09:15 ~ 11:45	C304 12:45 ~ 17:00



さらに細かい日程表は、アプリやwebプログラムのタイムテーブルをご覧ください